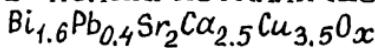


05.4

© 1991

СЖИМАЕМОСТЬ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КЕРАМИКЕ



Е.С. Б а л а н к и н а

Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) системы (*Bi*, *Pb*) – *Sr* – *Ca* – *O* являются наиболее перспективными для практического применения, т.к. обладают рядом преимуществ по сравнению со всеми материалами данного класса [1]. Исследования характеристик упругости имеют прикладное значение и представляют исходные данные для проверки и совершенствования существующих модельных представлений о поведении ВТСП.

В данной работе ультразвуковым резонансным методом [2] измерен объемный модуль упругости (*B*) на двух образцах в форме дисков диаметром 15 мм и толщиной 3 мм керамики состава $\text{Bi}_{1.6}\text{Pb}_{0.4}\text{Sr}_2\text{Ca}_{2.5}\text{Cu}_{3.5}\text{O}_x$ в интервале (85–300) К и дано теоретическое обоснование наблюдаемых аномалий.

Исследуемая ВТСП керамика получена методом твердофазного синтеза при ~ 840 °С и имеет пикнometрическую плотность 4.00 г/см³. Фазовый состав и параметры кристаллической решетки определялись на дифрактометре ДРОН-1.5 (излучение CuK_α). Рентгеновский фазовый анализ показал, что образцы являются однофазными (фаза 2233) с точностью до 5 % с параметрами решетки $a=3.82$ и $c=37.07$ Å. Из температурной зависимости намагниченности определены температуры начала $T_{\text{CH}}=102$ и конца $T_{\text{CK}}=95$ К перехода в сверхпроводящее состояние. Погрешность определения относительного изменения модуля *B* (при доверительной вероятности $\delta=0.95$) составляет $4B(T)/B \leq 0.3$ %. Перед исследованием *B*(*T*) образец был проциклирован от комнатной температуры до 85 К и отожжен при 483 К в течение получаса.

Объемный модуль упругости (см. рис. 1) монотонно возрастает при понижении температуры и имеет ярко выраженные аномалии в виде скачка и изменения наклона при ~ 102 , 120, 200, 255 К. В области, близкой к сверхпроводящему переходу ($T_c + 15$ –30 К), аномальное отклонение наблюдали [3, 4] на зависимости *a*(*T*), *c*(*T*), объема элементарной ячейки, модуля Юнга и внутреннего трения, что согласуется с полученными данными по модулю *B*. Данная аномалия наблюдалась [5] также для сверхпроводящих окисных керамик на основе *Y* и *Tl*. На основании исследования *a*(*T*), *c*(*T*), скорости и затухания звука, теплоемкости, ИК-спектров сделано предположение [6], что в окрестности 200 К происходит упорядоченное смещение атомов *Bi* и *O* вдоль

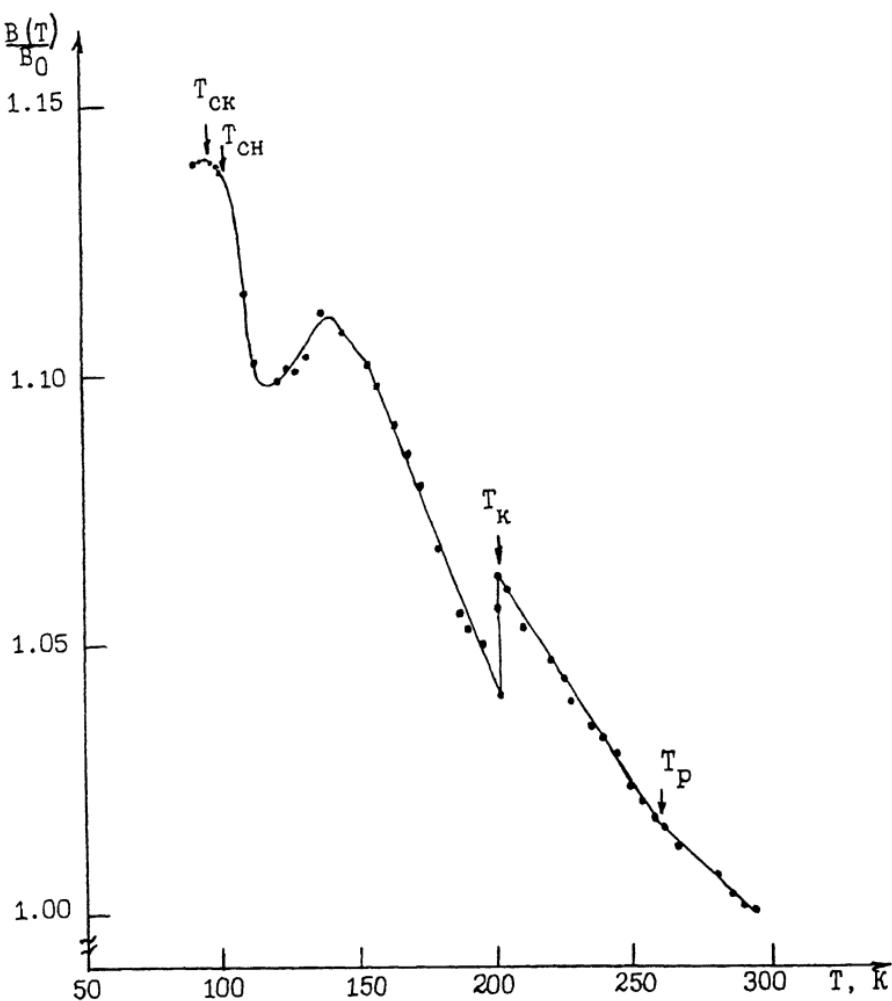


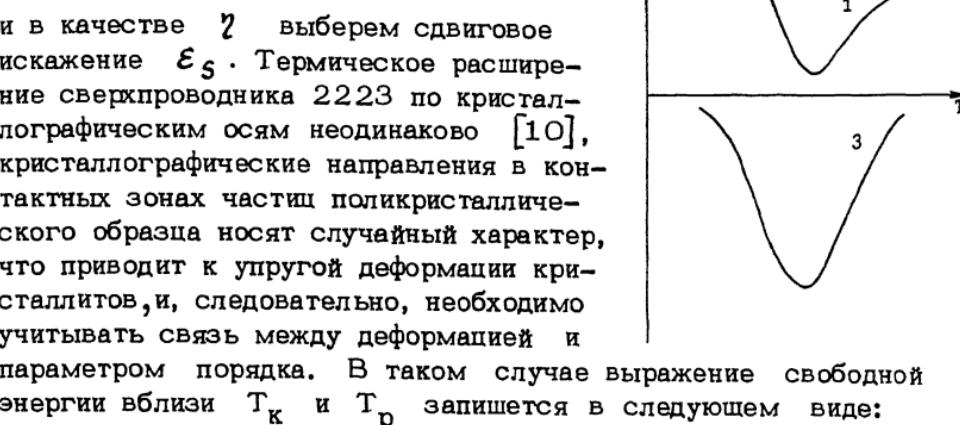
Рис. 1. Температурная зависимость приведенного объемного модуля упругости. $B_0 = 30.0$ ГПа.

направлений $\langle 110 \rangle$ из высокотемпературных позиций в $Bi - O$ плоскостях с сохранением только ближнего порядка. В работе [7] сделано предположение, что аномалия при 250 К вызвана искажениями в плоскости $Bi - O$. Эксперименты по рентгеновской дифракции установили, что симметрия решетки не меняется при охлаждении от комнатной температуры вплоть до 80 К [4, 8].

Объяснения аномалий на зависимости $B(T)$ проведем с учетом вкладов возможных механизмов возникновения особенностей в свободную энергию F . В окрестности фазового перехода теория Ландау [9] предполагает разложимость F по степеням параметра порядка η и возможность ограничиться конечным числом членов разложения. Аномалии $B(T)$ при $T_k \sim 200$ и $T_p \sim 255$ К, как упоминалось выше, обусловлены сдвиговым искажением решетки

Рис. 2. Схематическая иллюстрация возникновения особенности на температурной зависимости объемного модуля упругости.

1 – полный объемный модуль упругости, 2 – решеточный вклад, 3 – вклад от распаривания биполяронов.



и в качестве γ выберем сдвиговое искажение ε_s . Термическое расширение сверхпроводника 2223 по кристаллографическим осям неодинаково [10], кристаллографические направления в контактных зонах частиц поликристаллического образца носят случайный характер, что приводит к упругой деформации кристаллитов, и, следовательно, необходимо учитывать связь между деформацией и параметром порядка. В таком случае выражение свободной энергии вблизи T_k и T_p запишется в следующем виде:

$$F(T, \varepsilon_\nu, \varepsilon_s) = F_0(T) + \frac{\alpha'(T-T_k)}{2} \varepsilon_s^2 + \frac{\beta}{4} \varepsilon_s^4 - (\varphi \varepsilon_\nu + \beta \varepsilon_\nu^2) \varepsilon_s^2 + \frac{B_0 \varepsilon_\nu^2}{2}, \quad (1)$$

где ε_ν – объемная упругая деформация, B – объемный модуль упругости, не связанный с фазовым переходом, φ , β – коэффициенты, учитывающие связь между параметром порядка и деформацией. Это разложение справедливо в окрестности T_0 (T_p , T_k), за исключением узкого интервала вблизи самой точки фазового перехода, где велика роль флуктуаций параметра порядка. Зависимость ε_s от температуры и деформации определяется из условия минимальности F :

$$\varepsilon_s = \pm \left[\frac{\alpha'(T_0^* - T)}{\beta} \right]^{1/2}. \quad (2)$$

Здесь $T_0^* = T_0 + \frac{\varphi}{\alpha'} \varepsilon_\nu + \frac{\beta}{\alpha'} \varepsilon_\nu^2$ (3), т.е. деформация осуществляется перенос фазового перехода и связанных с ним аномалий по шкале температуры, что подтверждают экспериментальные результаты работ [11, 12]. Используя известное выражение для $B = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial \varepsilon_\nu^2} \right)$ (4) и выражения (1), (2), получим перенормировку B_0 ниже T_0^* :

$$B = B_0 - \frac{(\alpha')^2}{\delta} \left[\left(\frac{\partial T_0^*}{\partial \varepsilon_V} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 T_0^*}{\partial \varepsilon_V^2} \right) (T_0^* - T) \right]. \quad (5)$$

Согласно выражению (5), при $T_p \sim 255$ К $\left(\frac{\partial T_0^*}{\partial \varepsilon_V} \right) = 0$ (см. рис. 1).

Так как B всегда положительная величина, то скачок модуля B при $T \sim 200$ К имеет отрицательное значение, что и наблюдается в эксперименте. Следует отметить, что при такой перенормировке $B(T)$ можно определить характер зависимости температуры фазового перехода по температурной зависимости модуля упругости.

Так, в частности, для $T_k = 200$ К, как видно из рис. 1, $\frac{\partial^2 T_k^*}{\partial \varepsilon_V^2} < 0$ и, следовательно, на зависимости $T_k^*(\varepsilon_V)$ будет наблюдаться минимум при $\varepsilon_V^* = \frac{\partial T_k^*}{\partial \varepsilon_V} / \frac{\partial^2 T_k^*}{\partial \varepsilon_V^2}$.

Предшествующую сверхпроводящему переходу особенность на модуле B при использовании биполярного механизма сверхпроводимости можно объяснить частичным распариванием биполяронов [13, 14]. В биполярном кристалле зонная структура представляет собой две узкие зоны – полярную и биполярную, разделенные щелью Δ (энергия связи биполярона). Пренебрежем шириной обеих зон по сравнению с Δ , т.е. в простейшем приближении имеем дело с двухуровневой моделью.

Свободная энергия системы имеет вид [15]:

$$F = \frac{N}{2} \left[2E_p - \frac{\Delta}{2} - T \ln \left(2ch \frac{\Delta}{2T} \right) \right], \quad (6)$$

где N – полное число поляронов, E_p – энергия полярона. Используя выражения (4), (6) и считая, что $\Delta \sim 1/\varepsilon_V$ [14], получим добавку к B .

$$B_s = -\frac{n}{4} \Delta^2 \left[2 + 2 \ln \frac{\Delta}{2T} - \frac{\Delta}{2T} \frac{1}{ch^2 \frac{\Delta}{2T}} \right], \quad (7)$$

где n – концентрация поляронов. Зависимость (7) имеет минимум при $T \sim \frac{\Delta}{3}$, который и наблюдается при $T \sim 120$ К, что схематично показано на рис. 2.

На температурной зависимости B (см. рис. 1) при T_c не наблюдается скачка смягчения, предсказываемого термодинамическим анализом в рамках теории среднего поля. В рамках теории биполярной сверхпроводимости при T_c , согласно работе [16], наблюдается изменение наклона в скорости звука (происходит ужесточение решетки). Вследствие недостаточного количества экспериментальных данных в сверхпроводящем состоянии, трудно судить о характере поведения модуля B .

Подводя итог, следует подчеркнуть, что сверхпроводящему переходу предшествует постепенное частичное спаривание поляронов, которое приводит к аномальной зависимости $B(T)$. Предложенная перенормировка B в области T_k и T_p объясняет экспериментально наблюдаемый гистерезис.

Автор благодарен Ю.Ф. Бычкову за постоянное внимание к работе, В.Н. Яльцеву за обсуждение ряда вопросов, В.П. Жукову за ценные замечания и обсуждение работы в целом.

Список литературы

- [1] Васильев В.Н., Наумчик В.Д., Белопольская Т.В., Трофимов В.Б., Волков М.П., Егоров А.И. // СФХТ. 1991. Т. 4. № 1. С. 169-176.
- [2] Баланкин А.С., Бычков Ю.Ф., Яковлев Е.И. // ФММ. 1983. Т. 56. № 1. С. 128-133.
- [3] Chen X., Shen H., Wang Y. // Modern Physics Letters B. 1989. V. 3. N 16. P. 1241-1246.
- [4] Yuan S.L., Guan W.Y., Chen Z.J., Huang Y.L., Jia Y.B., Zheng J.Q., Zhuy B., Wang W., Zheng G.G. // Modern Physics Letters B. 1989. V. 3. N 9. P. 685-693.
- [5] Wang Y., Wu J., Shen H., Zhu J., Chen X., Yan Y., Zhao Z. // Phys. Rev. B. 1990. V. 41. N 13. P. 8981-8985.
- [6] Yusheng H., Jiong X., Hsin W., Aisheng H., Jincang Z., Fanggao C. // Physica C. 1989. V. 161. N 2. P. 226-232.
- [7] Reddy P.V., Ramaiah Y.V. // Solid State Commun. 1990. V. 74. N 5. P. 377.
- [8] Wang Y., Chen X., Shen H., Sun L. // Physica C. 1989. V. 162-164. P. 456-457.
- [9] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1976. 583 с.
- [10] Журков В.В., Иванов С.А., Буш А.А., Романов Б.Н. // СФХТ. 1990. Т. 3. № 10. Ч. 1. С. 2258-2266.
- [11] Yusheng H., Sihan L., Jiong X., Aisheng H., Jincang Z., Fanggao C., Chonglie W., Zhanhui S., Jiankai H., Qianlin Z. // J. Phys. Condens. Matter. 1991. V. 2. P. 1841-1852.

- [12] Fukami T., Youssef A., Horie Y., Mase S. // Physica, 1989. V. 161. P. 34-38.
- [13] Alexandrov A.S. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 1. P. 924-927.
- [14] Alexandrov A.S., Ranninger J. // Phys. Rev. B. 1981. V. 23. N 4. P. 1796-1801.
- [15] Александров А.С., Корнилович П.Э., Шевченко А.Д., Шульженко А.А. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 1. С. 303-305.
- [16] Alexandrov A.S., Ranninger J. // Physica C. 1989. V. 157. P. 367-371.

Поступило в Редакцию

27 июня 1991 г.

В окончательной редакции

4 октября 1991 г.